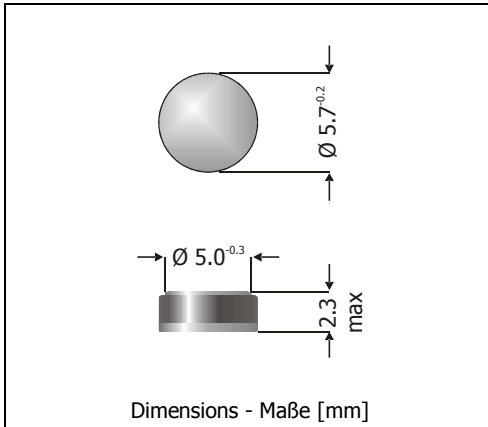


## AG6A ... AG6M

### Silicon Rectifier Cells with Polysiloxane Cover Silizium-Gleichrichterzellen mit Polysiloxan-Abdeckung

Version 2012-02-22



Nominal current Nennstrom	6 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Weight approx. –Gewicht ca.	0.3 g

Standard packaging bulk  
Standard Lieferform lose



#### Maximum ratings

#### Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
AG6A	50	80
AG6B	100	130
AG6D	200	250
AG6G	400	450
AG6J	600	700
AG6K	800	1000
AG6M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	6 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	$I_{FRM}$	40 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	360/400 A
Rating for fusing, $t < 10\text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	650 A <sup>2</sup> s
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	-50...+125°C -50...+150°C

#### Characteristics

#### Kennwerte

Forward voltage – Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 6\text{ A}$	$V_F$	< 0.95 V
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	$I_R$	< 10 $\mu\text{A}$

1 Max. temperature of the cell  $T = 125^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Zelle  $T = 125^\circ\text{C}$